NPN BU508DF

SILICON DIFFUSED POWER TRANSISTOR

The BU508DF is a NPN epitaxial-base transistor in TO3PFa package with integrated efficiency diode.
It is intended for high voltage, high-speed.
Primarily for use in horizontal deflection circuits of colour television receivers.
Compliance to RoHS.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Ratings		Value	Unit
V_{CBO}	Collector-Base Voltage		1500	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage		700	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage		5	V
I_C	Collector Current		8	A
I_{CM}	Collector Current Peak		15	A
I_B	Base Current		4	A
I_{BM}	Base Current Peak		6	A
P_T	Total Dissipation	@ T_{mb} < 25°	34	W
t_J	Junction Temperature		150	°C
t_s	Storage Temperature range		-65 to +150	

THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Ratings	Conditions	Value		Unit
			Typ.	Max	
R_{thJC}	Junction To Heatsink	Without Heatsink Compound	-	3.7	K/W
	Junction To Heatsink	With Heatsink Compound	-	2.8	
	Junction Ambient	In Free Air	35	-	

NPN BU508DF

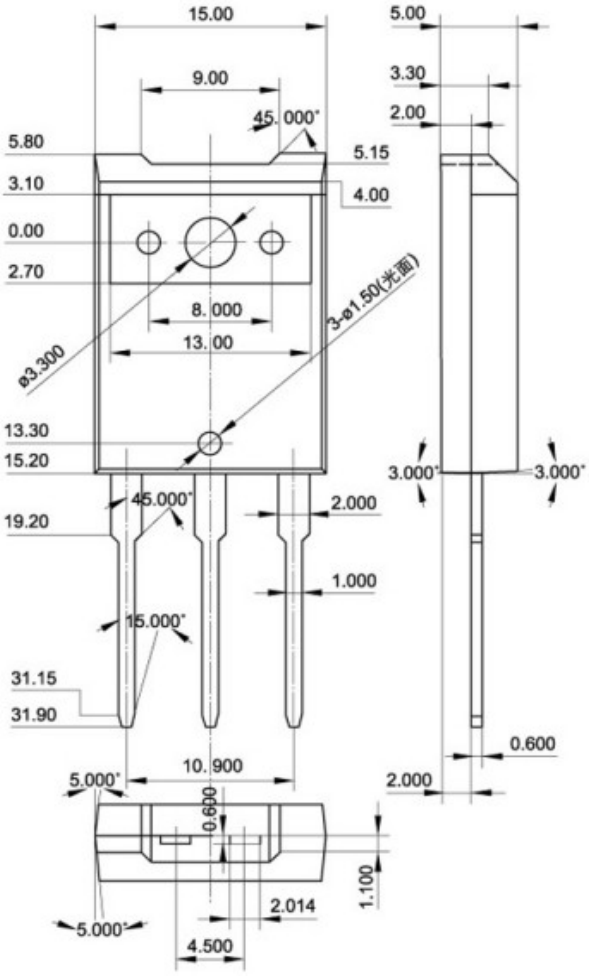
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

TC=25°C unless otherwise noted

Symbol	Ratings	Test Condition(s)	Min	Typ	Max	Unit
V_{CEO}	Collector-Emitter Breakdown Voltage	I_C= 100 mA, I_B=0 L= 25mH	700	-	-	V
I_{CES}	Collector Cutoff Current	V_{BE} =0, V_{CE} = 1500 V	-	-	1	mA
		V_{BE} =0, V_{CE} = 1500 V T_j =125°C	-	-	2	
I_{EBO}	Emitter Cutoff Current	V_{EB}= 5 V, I_C=0	-	-	300	mA
$V_{CE(SAT)}$	Collector-Emitter saturation Voltage	I_C= 4.5 A, I_B= 1.6 A	-	-	1	V
$V_{BE(SAT)}$	Base-Emitter saturation Voltage	I_C= 4.5 A, I_B= 2 A	-	-	1.1	
V_F	Diode Forwardvoltage	I_F= 4.5 A	-	1.6	2	V
h_{FE}	DC Current Gain	I_C= 500 mA, V_{CE} = 5 V	10	-	30	-
C_{OB}	Output Capacitance	VCB = 10 V, I_E=0, f= 1MHz	3	-	-	A
f_T	Transition Frequency	V_{CE}= 5 V, I_C= 100 mA	-	7	-	MHz

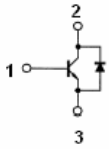
NPN BU508DF

MECHANICAL DATA CASE TO3PFa



Pin 1 :	Base
Pin 2 :	Collector
Case :	Emitter
Case :	Isolated

1 2 3



Revised October 2012

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Comset Semiconductors assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may results from its use. Data are subject to change without notice. Comset Semiconductors makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does Comset Semiconductors assume any liability arising out of the application or use of any product and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. Comset Semiconductors' products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems.

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331